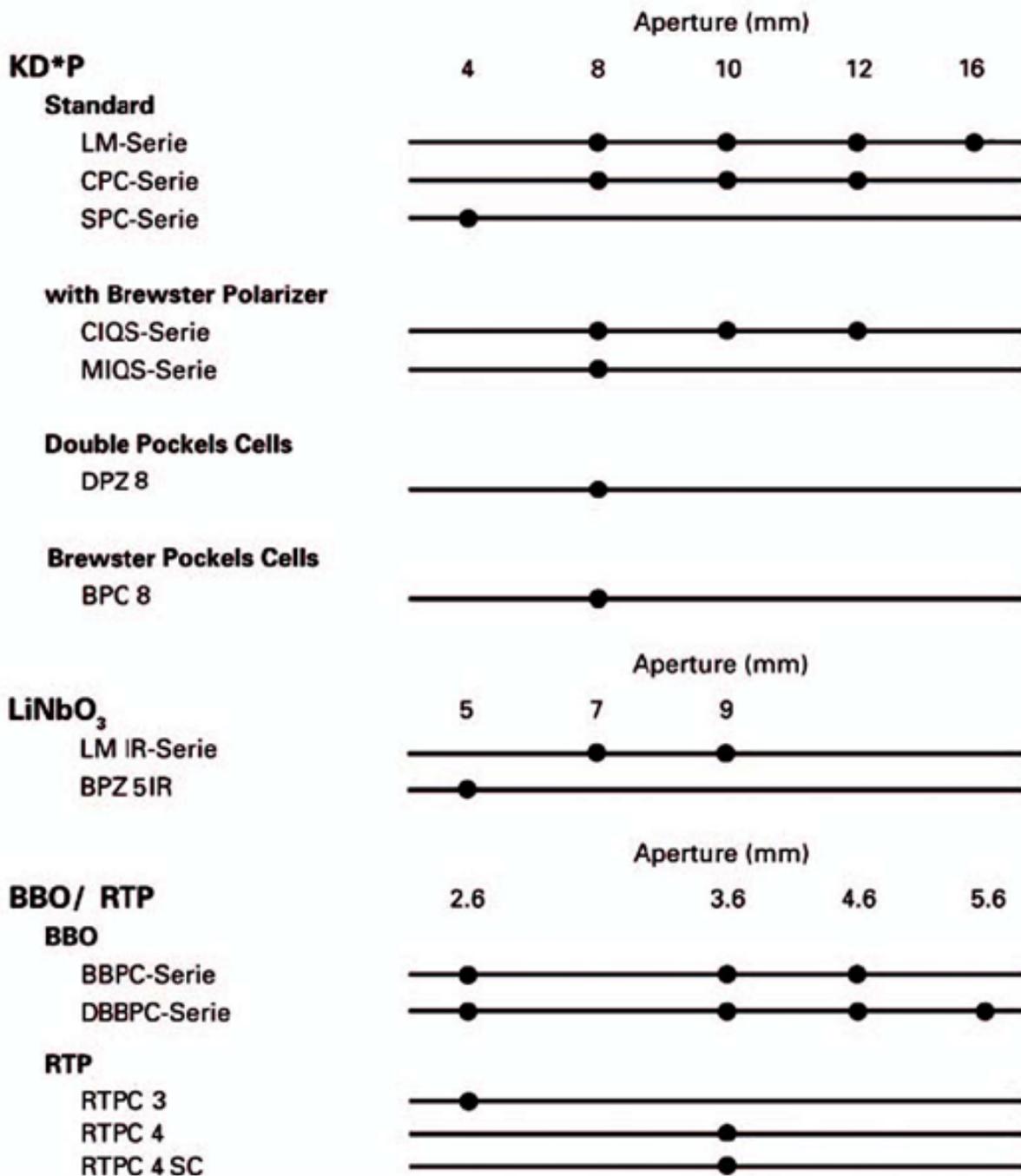




LINOS 普克尔盒系列选择指南

可根据您的需求定制 250 nm 至 3 μm 工作范围的普克尔盒（比其它公司波段宽），四种材料分别在用于不同波段：

- **KD*P, 0.25 μm - 1.1 μm**
- **BBO, 0.25 μm - 1.3 μm**
- **RTP, 0.5 μm - 1.5 μm**
- **LiNbO₃, 1.5 μm - 3 μm**





KD*P 晶体普克尔盒 - 标准型

LM 系列

特性:

- 基于 KD*P 晶体
- 高氘化率: > 98%
- 波前畸变: < $\lambda/4$
- 损伤阈值: > 500 MW/cm² at 1064 nm, 10 ns, 1 Hz (典型值, 非保证值)
- 普通型, 水浸型 (IM) 或者溶胶型 (SG) 版本可选
- 可选项: $\lambda/4$ 波片



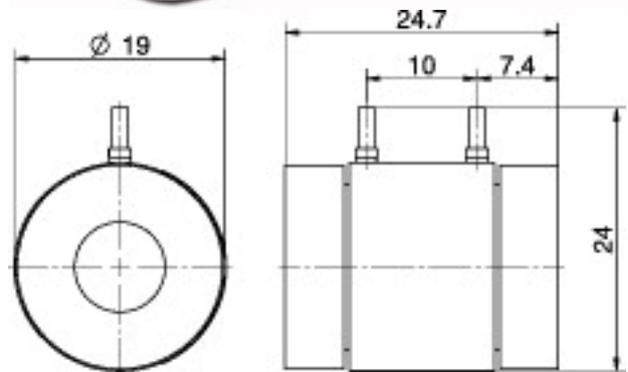
产品型号	通光孔径 (mm)	透过率典型值 (%)	消光比 【无外加电压】	$\lambda/4$ 电压值	电容值 (pF)
LM 8	Ø 8	91	> 1000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	4
LM 8 IM	Ø 8	98	> 1000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	4
LM 8 SG	Ø 7.5	98	> 1000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	4
LM 10	Ø 10	91	> 1000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	5
LM 10 IM	Ø 10	98	> 1000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	5
LM 10 SG	Ø 9.5	98	> 1000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	5
LM 12	Ø 12	91	> 1000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	6
LM 12 IM	Ø 12	98	> 1000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	6
LM 12 SG	Ø 11	98	> 1000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	6
LM 16	Ø 16	91	> 1000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	6
LM 16 IM	Ø 16	98	> 1000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	6
LM 16 SG	Ø 15	98	> 1000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	6



CPC 系列

特性:

- 基于 KD*P 晶体
- 紧凑型设计应用于 OEM
- 高氘化率: > 98%
- 波前畸变: < $\lambda/4$
- 损伤阈值: > 500 MW/cm² at 1064 nm, 10 ns, 1 Hz (典型值, 非保证值)
- 普通型型, 水浸型 (IM) 或者溶胶型 (SG) 版本可选
- 可选项: $\lambda/4$ 波片



CPC 8 (IM) (SG)

其他参数规格可根据您的要求提供。请在订购时说明波长范围。

产品型号	通光孔径 (mm)	透过率典型值 (%)	消光比【无外加电压】	$\lambda/4$ 电压值	电容值 (pF)
CPC 8	Ø 8	91	> 3000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	4
CPC 8 IM	Ø 8	98	> 3000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	4
CPC 8 SG	Ø 7.5	98	> 3000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	4
CPC 10	Ø 10	91	> 3000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	6
CPC 10 IM	Ø 10	98	> 3000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	6
CPC 10 SG	Ø 9.5	98	> 3000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	6
CPC 12	Ø 12	91	> 3000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	8
CPC 12 IM	Ø 12	98	> 3000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	8
CPC 12 SG	Ø 11	98	> 3000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	8



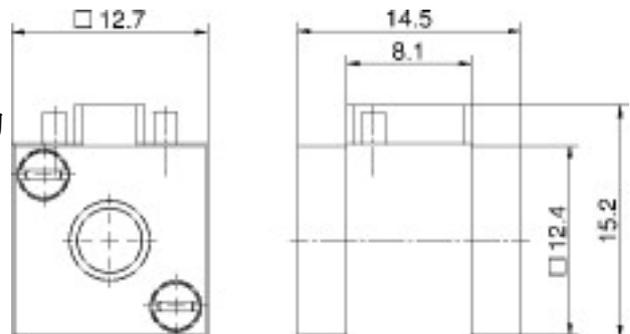
SPC 4 系列

特性:

- 基于 KD*P 晶体
- 超小型设计应用于 OEM
- 高氘化率: > 98%
- 波前畸变: < $\lambda/4$
- 损伤阈值: > 500 MW/cm² at 1064 nm, 10 ns, 1 Hz (典型值, 非保证值)
- 普通型, 水浸型 (IM) 或者溶胶型 (SG) 版本可选
- 可选项: $\lambda/4$ 波片



其他参数规格可根据您的要求提供。请在订购时说明波长范围。



SPC 4 (IM) (SG)

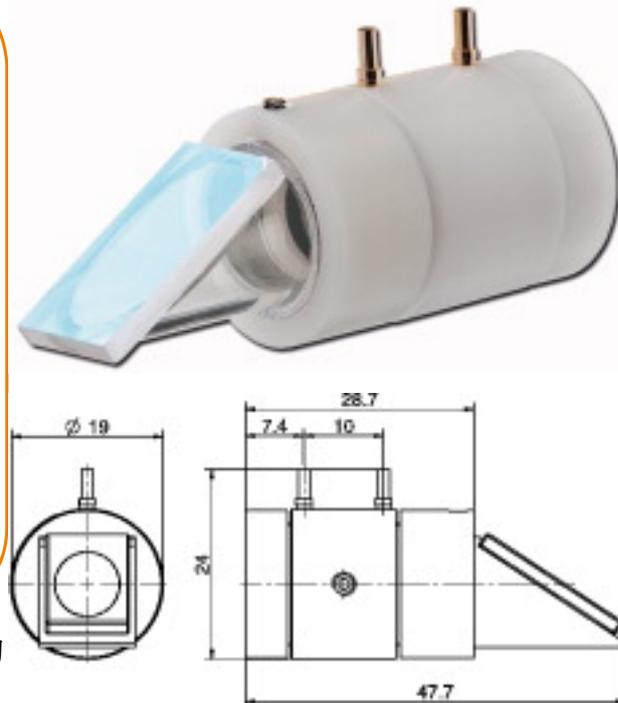
产品型号	通光孔径 (mm)	透过率典型值 (%)	消光比【无外加电压】	$\lambda/4$ 电压值	电容值 (pF)
SPC 4	$\emptyset 4$	91	> 3000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	
SPC 4 IM	$\emptyset 4$	98	> 3000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	
SPC 4 SG	$\emptyset 3.5$	98	> 3000:1	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	



KD*P 晶体普克尔盒 - 带布鲁斯特 偏振片 CIQS 系列

特性:

- 基于 KD*P 晶体
- 紧凑型设计应用于 OEM
- 配置有集成的, 预校准的布鲁斯特偏振片
- 高氘化率: $> 98\%$
- 波前畸变: $< \lambda/4$
- 损伤阈值: $> 500 \text{ MW/cm}^2$ at 1064 nm, 10 ns, 1 Hz (典型值, 非保证值)
- 普通型, 水浸型 (IM) 或者溶胶型 (SG) 版本可选
- 可选项: $\lambda/4$ 波片



CIQS 8 (IM) (SG)

其他参数规格可根据您的要求提供。请在订购时说明波长范围。

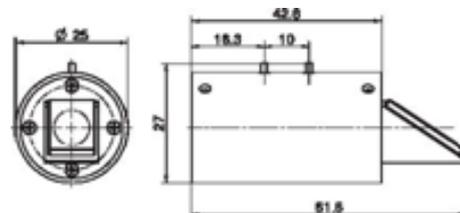
产品型号	通光孔径 (mm)	透过率典型值 (%)	消光比【无外加电压】	$\lambda/4$ 电压值	电容值 (pF)
CIQS 8	8	88	$> 500:1$	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	4
CIQS 8 IM	8	95	$> 500:1$	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	4
CIQS 8 SG	7.5	95	$> 500:1$	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	4
CIQS 10	10	88	$> 500:1$	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	6
CIQS 10 IM	10	95	$> 500:1$	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	6
CIQS 10 SG	9.5	95	$> 500:1$	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	6
CIQS 12	12	88	$> 500:1$	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	8
CIQS 12 IM	12	95	$> 500:1$	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	8
CIQS 12 SG	11	95	$> 500:1$	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	8



KD*P 晶体普克尔盒 - 带布鲁斯特偏振片 MIQS 系列

特性:

- 基于 KD*P 晶体
- 紧凑型设计应用于 OEM
- 配置有集成的，预校准的布鲁斯特偏振片
- 高氘化率: $> 98\%$
- 波前畸变: $< \lambda/4$
- 损伤阈值: $> 500 \text{ MW/cm}^2$ at 1064 nm, 10 ns, 1 Hz (典型值, 非保证值)
- 普通型, 水浸型 (IM) 或者溶胶型 (SG) 版本可选
- 可选项: $\lambda/4$ 波片



其他参数规格可根据您的要求提供。请在订购时说明波长范围。

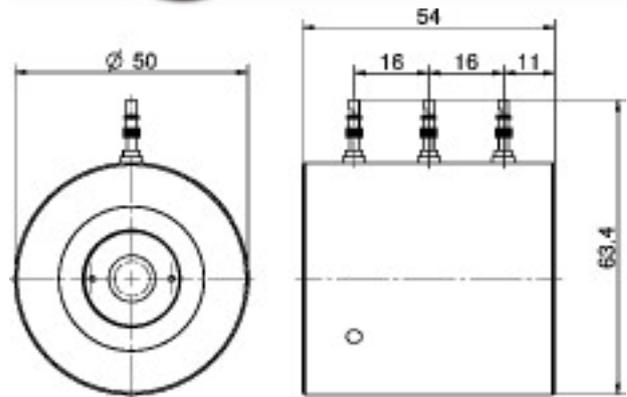
产品型号	通光孔径 (mm)	透过率典型值 (%)	消光比【无外加电压】	$\lambda/4$ 电压值	电容值 (pF)
MIQS 8	$\varnothing 8$	88	$> 500:1$	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	4
MIQS 8 IM	$\varnothing 8$	95	$> 500:1$	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	4
MIQS 8 SG	$\varnothing 7.5$	95	$> 500:1$	3.2 kV at 1064 nm, 20° C	4



KD*P 晶体普克尔盒 - DPZ 系列

特性:

- 基于 KD*P 晶体
- 双晶体串联
- 高氘化率: $> 98\%$
- 波前畸变: $< \lambda/4$
- 损伤阈值: $> 500 \text{ MW/cm}^2$ at 1064 nm, 10 ns, 1 Hz (典型值, 非保证值)
- $\lambda/4$ 电压为 1.6 kV at 1064 nm, 20°C
- 普通型, 水浸型 (IM) 或者溶胶型 (SG) 版本可选



DPZ 8

其他参数规格可根据您的要求提供。请在订购时说明波长范围。

产品型号	通光孔径 (mm)	透过率典型值 (%)	消光比【无外加电压】	$\lambda/4$ 电压值	电容值 (pF)
DPZ 8	$\text{Ø} 8$	84	$> 500:1$	3.2 kV at 1064 nm, 20°C	8
DPZ 8 IM	$\text{Ø} 8$	95	$> 1000:1$	3.2 kV at 1064 nm, 20°C	8
DPZ 8 SG	$\text{Ø} 7.5$	95	$> 1000:1$	3.2 kV at 1064 nm, 20°C	8



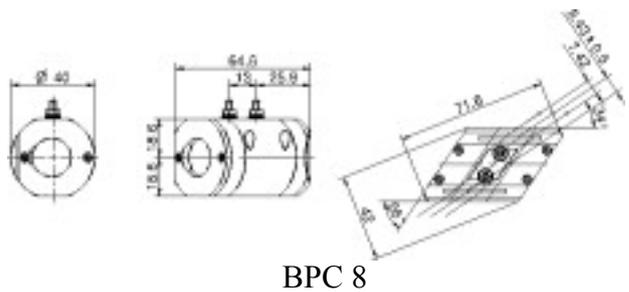
布鲁斯特切面 KD^*P 晶体普克尔盒 - BPC 8

特性:

- 基于 KD^*P 晶体
- 布鲁斯特切面的晶体
- 无镀膜
- 对激光有高透过率并且低放大
- 高氘化率: $> 98\%$
- 光束偏移: 8.4 mm
- 波前畸变: $< \lambda/4$
- 损伤阈值: $> 500 \text{ MW/cm}^2$ at 1064 nm, 10 ns, 1 Hz (典型值, 非保证值)



其他参数规格可根据您的要求提供。请在订购时说明波长范围。



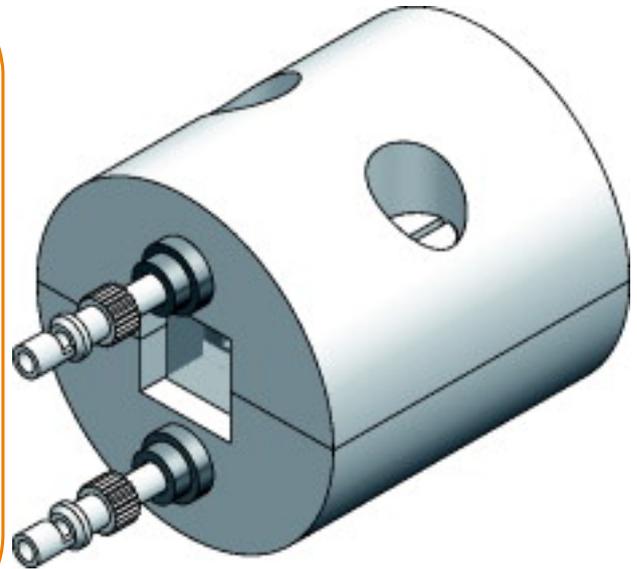
产品型号	通光孔径 (mm)	透过率典型值 (%)	消光比【无外加电压】	$\lambda/4$ 电压值	电容值 (pF)
BPC 8	$\text{Ø } 7.4$	99	$> 1000:1$	2.5 kV at 755 nm, 20° C	4



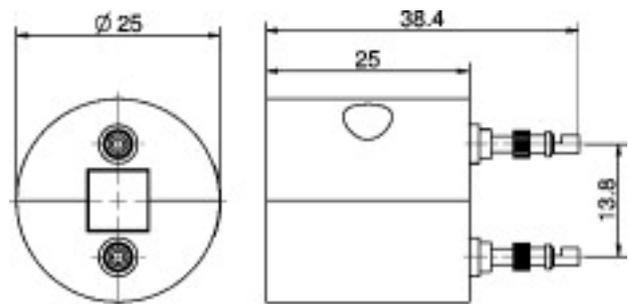
LiNbO₃ 晶体普克尔盒

特性:

- 基于 LiNbO₃ 晶体
- 推荐用于 Er:YAG, Ho:YAG, Tm:YAG lasers
- 波长范围上至 3 μm
- 布鲁斯特晶体 BPZ 5 IR 用于激光器, 低放大
- 紧凑型设计
- 波前畸变: $\lambda/4$
- 损伤阈值: > 100 MW/cm² at 1064 nm, 10 ns, 1 Hz (典型值, 非保证值)



其他参数规格可根据您的要求提供。请在订购时说明波长范围。



LM 7 IR

产品型号	通光孔径 (mm)	透过率典型值 [%]	消光比 【无外加电压】	$\lambda/4$ 电压值
LM 7 IR	7.45 x 7.45	98	>100:1	3 (+15 % -10 %) at 2 μm
LM 9 IR	9 x 9	98	>100:1	4.5 (+15 % -10 %) at 3 μm
BPZ 5 IR	5 x 5	99	>100:1	1.9 (+15 % -10 %) at 2 μm



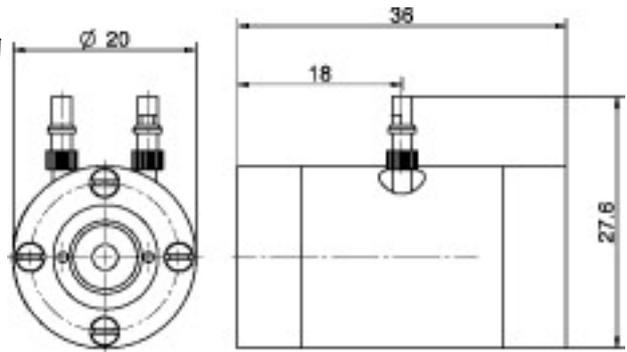
BBO 晶体普克尔盒 - BBPC 系列

特性:

- 基于 BBO 晶体
- 适合作为高重复率 Q 开关
- 波前畸变: $< \lambda/4$
- 损伤阈值: $> 300 \text{ MW/cm}^2$ at 1064 nm, 10 ns, 1 Hz (典型值, 非保证值)
- 可选项: 可集成布鲁斯特偏振片 BBPC n BP
- 可选项: $\lambda/4$ 波片 BBPC n WP
- 可选项: 压电衰减器 BBPC n pp



其他参数规格可根据您的要求提供。请在订购时说明波长范围。



BBPC

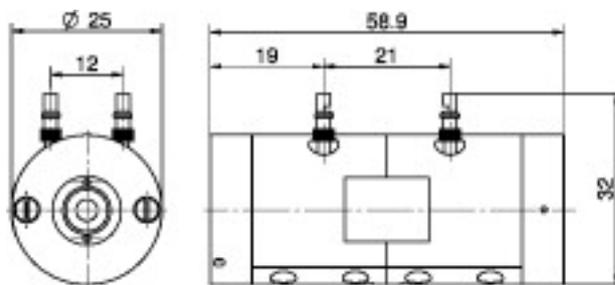
产品型号	通光孔径 (mm)	透过率典型值 (%)	消光比【无外加电压】	$\lambda/4$ 电压值	电容值 (pF)
BBPC 3	Ø2.6	98	$>1000:1$	3.6kV	4
BBPC 4	Ø3.6	98	$>1000:1$	4.8kV	4
BBPC 5	Ø4.6	98	$>1000:1$	6.0kV	4



BBO 双晶体普克尔盒 - DBBPC 系列

特性:

- 基于 BBO
- 双晶体串联结构
- 带压电衰减器
- 适合作为高重复率 Q 开关
- 波前畸变: $< \lambda/4$
- 损伤阈值: $> 300 \text{ MW/cm}^2$ at 1064 nm, 10 ns, 1 Hz (典型值, 非保证值)



DBBPC

其他参数规格可根据您的要求提供。请在订购时说明波长范围。

产品型号	通光孔径 (mm)	透过率典型值 (%)	消光比【无外加电压】	$\lambda/4$ 电压值	电容值 (pF)
DBBPC 3	Ø2.6	98	$> 1000:1$	1.8kV	8
DBBPC 4	Ø3.6	98	$> 1000:1$	2.4kV	8
DBBPC 5	Ø4.6	98	$> 1000:1$	3.0kV	8
DBBPC 6	Ø5.6	98	$> 1000:1$	3.6kV	8



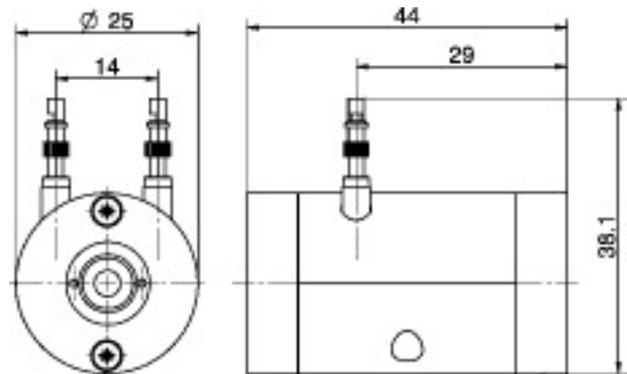
RTP 晶体普克尔盒 - RTPC 系列

特性:

- 基于 RTP 晶体
- 双晶体相互补偿结构
- 适合作为高重复率 Q 开关
- 波前畸变: $< \lambda/4$
- 损伤阈值: $> 600 \text{ MW/cm}^2$ at 1064 nm, 10 ns, 1 Hz (典型值, 非保证值)
- SC 版本采用的是短晶体
- 可选项: 可集成布鲁斯特偏振片 RTPC n BP
- 可选项: $\lambda/4$ 波片 RTPC n WP



其他参数规格可根据您的要求提供。请在订购时说明波长范围。



RTPC 3, RTPC 4

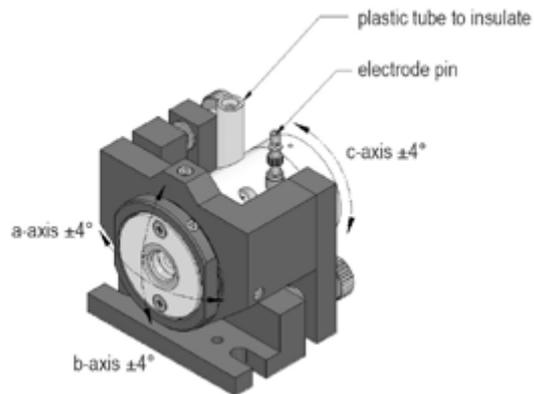
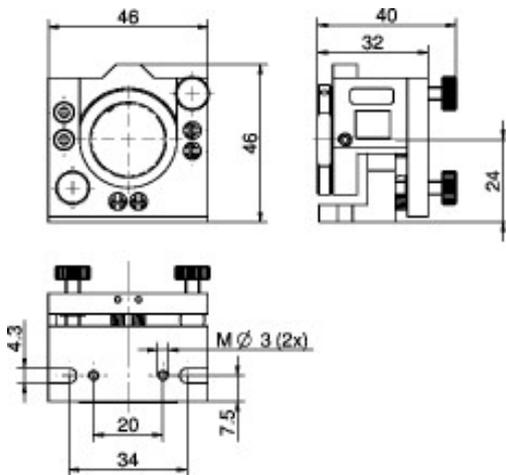
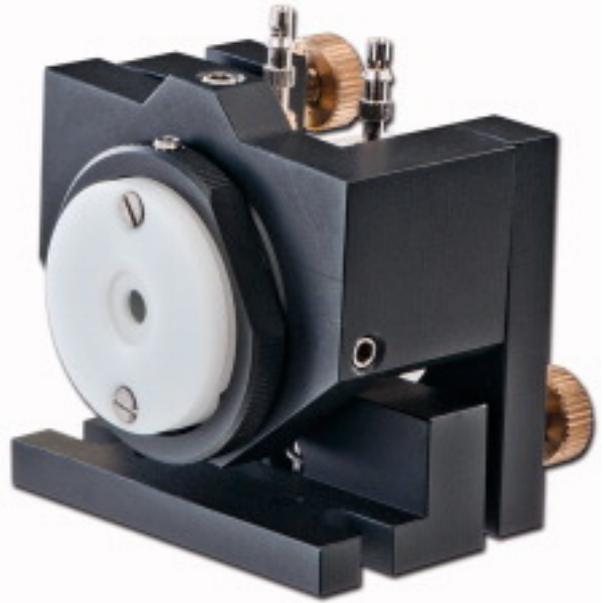
产品型号	通光孔径 (mm)	透过率典型值 (%)	消光比【无外加电压】	$\lambda/4$ 电压值	电容值 (pF)
RTPC 3	$\text{Ø} 2.6$	98	$> 200:1$	0.5 kV	3
RTPC 4 SC	$\text{Ø} 3.6$	98	$> 200:1$	1.3 kV	3
RTPC 4	$\text{Ø} 3.6$	98	$> 200:1$	0.65 kV	3



附件：LINOS 普克尔盒安装座

特性：

- 紧凑和稳定型设计
- 可轻松调整俯仰、偏航和旋转
- 拥有精细螺纹调节
- 可兼容上至 35 毫米的普克尔盒
- 用于 OEM 的特殊结构也可提供



结构示意图

尺寸 (mm)	普克尔盒直径 (mm)	倾斜范围	光束高度 (mm)
46 x 46 x 40	12.7	±4	24
46 x 46 x 40	19	±4	24
46 x 46 x 40	21	±4	24
46 x 46 x 40	23	±4	24
46 x 46 x 40	25	±4	24
46 x 46 x 40	25.4	±4	24
56 x 54 x 40	35	±4	24